









	<b>APT34N80B2C3G</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	APT34N80B2C3G
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Microsemi
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 800V 34A T-MAX
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">APT34N80B2C3G.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 9676 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	APT34N80B2C3G
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 34A T-MAX
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	9676 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3 Variant
Supplier Device-Gehäuse	T-MAX™ [B2]
Verlustleistung (max)	417W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	34A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	145 mOhm @ 22A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3.9V @ 2mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	355nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4510pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube



APT34N80B2C3G ist neu im Original, Suche APT34N80B2C3G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie APT34N80B2C3G Microsemi mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage APT34N80B2C3G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>APT34N80B2C3X</b> APT APT34N80B2C3X APT	 <b>APT34N80LC3G</b> Microsemi MOSFET N-CH 800V 34A TO-264	 <b>APT34M60</b> APT APT34M60 APT	 <b>APT34F60BG</b> Microsemi MOSFET N-CH 600V 34A TO-247
 <b>APT35GA90B</b> Microsemi IGBT 900V 63A 290W TO-247	 <b>APT34M120J</b> Microsemi MOSFET N-CH 1200V 34A SOT-227	 <b>APT35DL120HJ</b> Microsemi DIODE MODULE 1.2KV SOT227	 <b>APT35GA90BD15</b> Microsemi IGBT 900V 63A 290W TO247

### heiße Teile

Mehr

 APT30M30LFLL	 APT30M30LLL	 APT30M36JFLL	 APT30M36JLL	 APT30M36LFLL
 APT30M36LLL	 APT30M40JNR	 APT30M40JVFR	 APT30M40JVFRG	 APT30M40JVR
 APT30M40JVFRG	 APT30M40LVFR	 APT30M40LVR	 APT30M45JNR	 APT30M50JNR
 APT30M60J	 APT30M61BLLG	 APT30M85BVR	 APT31N80JC3	 APT3216CGC
 APT3216QBC/D	 APT32F120J	 APT32M80J	 APT33GF120LRDQ2G	 APT34M120J
 APT35GA90B	 APT35GA90BD1G	 APT35GP120B2DQ2G	 APT35GP120JDF2	 APT35GP120JDX
 APT35SM70B	 APT37F50B	 APT38F50J	 APT38F80B2	 APT38M50J
 APT39F60J	 APT4035JVR	 APT40DC120HJ	 APT40DC60HJ	 APT40DQ120B
 APT40DQ120BG	 APT40DQ60BCTG	 APT40DQ60BG	 APT40GF120JRD	 APT40GP60J
 APT40GP60LDF3	 APT40GT60BR	 APT40M35JVFR	 APT40M35JVR	 APT40M42JN

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited